









	<h2 style="color: red;">SI5920DC-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI5920DC-T1-E3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5920DC-T1-E3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 32168 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI5920DC-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32168 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	32 mOhm @ 6.8A, 4.5V
Leistung - max	3.12W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 4V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A

SI5920DC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5920DC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5920DC-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5920DC-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5933CDC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 3.7A 1206-8</p>	 <p><b>SI5920DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5915DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 3.4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5915DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 8V 3.4A 1206-8</p>
 <p><b>SI5922DU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 30V CHIPFET</p>	 <p><b>SI5920DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5915DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 3.4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5922DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 30V 6A POWERPAK</p>

### SI5920DC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	SI5920DC-T1-E3 / Siliconix	SI5920DC-T1-E3 Datenblatt	SI5920DC-T1-E3-Datenblätter	SI5920DC-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI5920DC-T1-E3
SI5920DC-T1-E3 Electronic		SI5920DC-T1-E3-Komponenten	SI5920DC-T1-E3-Verteiler	SI5920DC-T1-E3-Bild	SI5920DC-T1-E3-Teil
SI5920DC-T1-E3 Preis		SI5920DC-T1-E3 Hersteller	SI5920DC-T1-E3 Bild	SI5920DC-T1-E3 Aktie	SI5920DC-T1-E3 Inventar
SI5920DC-T1-E3 Neu		SI5920DC-T1-E3 Original	SI5920DC-T1-E3 garantiert	SI5920DC-T1-E3 RFQ	SI5920DC-T1-E3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited